

檔案：
保存年限：



中華民國台灣半導體產業協會 函

地址：新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 53 館 802 室

聯絡人及電話：顏嘉霈經理，03-5913477

受文者：國立清華大學

速別：最速件

密等及解密條件：無

發文日期：中華民國一一五年十月十五日

發文字號：(一一五)導協字第○四一號

附件：2027「TSIA 半導體獎：博士研究生」與「TSIA 半導體獎：具博士學位之新進研究人員」申請辦法、
申請表與推薦函

主旨：檢送本會 2027「TSIA 半導體獎：博士研究生」與「TSIA 半導體獎：具博士學位之新進研究人員」申請辦法與申請表等相關附件，請 惠予公布並推薦優秀博士研究生與具博士學位之新進研究人員參選。



說明：

- 一、本會為獎勵國內博士研究生及具博士學位之新進研究人員積極從事半導體之學術研究、發明或致力投入產業合作活動並有具體貢獻，特舉辦 2027「TSIA 半導體獎：博士研究生」與「TSIA 半導體獎：具博士學位之新進研究人員」選拔活動。
- 二、檢附相關申請辦法、申請表、推薦函等文件，惠請公布並推薦貴校優秀之博士研究生與具博士學位之新進研究人員參選。
- 三、依據博士研究生申請辦法第八條推薦方式，8-1 說明，各校依第三項規定向本會推薦最多 6 名博士研究生為原則。
- 四、依據具博士學位之新進研究人員申請辦法第八條推薦方式，各校可推薦最多 3 名研究員。

國立清華大學 115/10/16



1150020935

檔案：

保存年限：

五、受理申請日期為 2026 年 10 月 15 日至 2026 年 12 月 15 日止。

請於上述截止日前，依申請辦法相關規定請連結網址：

<https://forms.gle/otyX8p5MAQKTMYYEY7> 填寫基本資料，並將
9-1~9-5 推薦資料文件掃描為單一 PDF 檔案後上傳，以利建檔。
聯絡資訊請參見申請辦法第十三項規定。

六、得獎名單將於 2027 年 5 月 31 日以前公布於本會官網
www.tsia.org.tw 並通知貴校。

正本：國立臺灣大學、國立清華大學、國立陽明交通大學、國立成功大學、國立中央大學、
國立中正大學、國立中興大學、國立中山大學、國立臺灣科技大學、國立臺北科技大學、
國立高雄科技大學



理事長 侯永清

TSIA 半導體獎：具博士學位之新進研究人員申請辦法

民國 112 年 9 月 15 日修訂

一、目的：

台灣半導體產業協會(以下稱本會)為獎勵國內傑出具博士學位之新進研究人員積極從事半導體之學術研究、發明或致力投入產業合作並有具體貢獻者，特訂定本辦法。

二、獎項：

「TSIA 半導體獎：具博士學位之新進研究人員」一至二名，頒給獎牌乙座、並將其個人貢獻事蹟公告予本會之會員廠商並發表讓社會知悉及獎金新台幣 10 萬元整。

三、申請資格：

下列大學新進研究人員(含教師、研究人員、博士後)取得博士學位後 5 年內，在台灣學校從事研發及教學滿 2 年，以申請截止日為基準。2022 年度起從國立台灣大學、國立清華大學、國立陽明交通大學、國立成功大學、國立中央大學、國立中正大學、國立中興大學、國立中山大學，北科大、台科大與高科大共十一所大學之傑出新進研究人員中進行推薦，未來將陸續推廣至其它公私立大學。

四、申請時間：

本會於每年 10 月中旬函告各校並開放受理申請。受理申請時間為每年 10 月 15 日至 12 月 15 日止。

五、遴選委員會

由台灣半導體產業協會理事長為遴選委員會主委或委任，並邀請在半導體領域已有卓越成就之學者、專家及產業領導者為委員。

六、頒獎日期：

於次年之本會會員大會或年會中頒獎，獲獎者須親自出席受獎。因故經 TSIA 遴選委員會同意，理監事會核備，同意由其指導教授或該單位最高研發主管出席，受獎得改由他人代之。

七、申請方式：

7-1 申請者備妥申請文件，向各校校方提出申請；本會不直接受理申請。

7-2 請各校於申請截止日期前，向本會推薦。

八、推薦方式：

各校可推薦最多 3 名研究員。若上述申請推薦內容或過程中，有違反事實之情事發生並經查明屬實，本會得撤銷其獲獎資格及獎項。

九、申請文件：

9-1 申請表正本(有制式表格，請向各校索取-附件一) (此為最重要文件，請務必簡潔明確)。

9-2 推薦函正本(有制式表格，請向各校索取-附件二)。

9-3 身份證正反面影本各乙份(請黏貼於申請表內)。(為保護個資，請自行加註”影本僅限 TSIA 辦理半導體獎申請使用，禁止其他用途“。)

9-4 工作服務證明正本。

9-5 取得博士學位後，參與半導體學術研究、著作論文、發明成果、獲獎紀錄、專利榮譽、特殊貢獻、產學合作等傑出事蹟之相關佐證資料。

9-6 申請文件請掃描為單一 PDF 檔案後，上傳至申請表內之申請資料連結網址，以利建檔。

十、遴選方式：

由 TSIA 遴選委員會執行。

十一、其它：

本申請辦法由遴選委員會訂定，經 TSIA 理監事會核備後實施，日後若有修訂，亦同。

十二、若有未盡事宜，本會保留本辦法之變更、解釋及修訂之權利。

十三、聯絡資訊：

張世杰 TSIA 遴選委員會總幹事/國立清華大學教授

電話：(O) 03-574-2964

地址：新竹市 30013 光復路二段 101 號

國立清華大學 資訊工程學系

Email Address: scchang@cs.nthu.edu.tw

附件一、「TSIA 半導體獎：具博士學位之新進研究人員」申請表

申請編號 (由本會填寫)		申請日期 (西元年/月/日)	
-----------------	--	-------------------	--

一、個人基本資料：

學校名稱	(中文)		
	(英文)		
系所名稱	(中文)		
	(英文)		
申請人	(中文姓名)		(英文姓名)
身份證字號		生日	西元 年 月 日
戶籍地址			
通訊地址	(含 6 碼郵遞區號)		
電話	(市話) (手機)	Email	

二、學歷狀況：(請依最高學歷往下填寫)

學位	學校	科系	修習期間 (西元年/月~西元年/月)

三、工作經歷：(若有請填寫，並依最近工作經歷往下填寫)

任職公司	部門/職位	工作內容	任職期間 (西元年/月~西元年/月)

四、研究績效(含論文著作、專利發明、軟體、產品、產學合作、獲獎紀錄等)依重要性排序，最多 8 項，每項扼要敘述最多 5 行。論文著作之說明以第一作者(含共同第一作者)於國際頂尖期刊與會議發表之論文為優先；非第一作者者，請註明本人於該研究中具體貢獻。

請 (A) 提供統計成果；(B) 依重要性排序。

範例如下：

(A) 以第一作者發表 3 篇 IEDM，2 篇 Symp. VLSI，3 篇 IEEE EDL 期刊等

(B) 論文著作：

1. 作者-1、作者-2 等「論文標題」，IEDM，第 1-4 頁，2025 年 12 月

+重點條列方式撰寫，至多 5 行

2. XXX

五、可供徵詢之專家資料

姓名	服務單位/職稱	電話(公司/手機)	Email	與申請人之關係

六、自傳(500 字內)

2

七、自述研究成果或貢獻及其重要性(500 字內，請與“四、研究績效”之項目順序相符，並可將相關項目合併陳述其整體之貢獻與重要性)

八、身份證正反面影本

	
---	---

九、應備文件點檢表：

項目	請打“v”	文件名稱
9-1		申請表正本(有制式表格，請向各校索取-附件一)。
9-2		推薦函正本(有制式表格，請向各校索取-附件二)。
9-3		身份證正反面影本各乙份(請貼於本申請表)。
9-4		工作服務證明正本。
9-5		取得博士學位後，參與半導體學術研究、著作論文、發明成果、獲獎紀錄、專利榮譽、特殊貢獻、產學合作等傑出事蹟之相關佐證資料。
9-6		請連結網址 https://forms.gle/otyX8p5MAQKTMYEY7 ，填寫基本資料，並將 9-1~9-5 文件掃描為單一 PDF 檔案後上傳，以利建檔。



TSIA 半導體獎：博士研究生申請辦法

民國 114 年 7 月 4 日修訂

一、目的：

台灣半導體產業協會(以下稱本會)為獎勵國內傑出博士研究生積極從事半導體之學術研究、發明或致力投入產業合作並有具體貢獻者，特訂定本辦法。

二、獎項：

「TSIA 半導體獎：博士研究生」十名，每名頒給獎牌乙座、並將其個人貢獻事蹟公告予本會之會員廠商並發表讓社會知悉及獎金新台幣 8 萬元整。

三、申請資格：

3-1 自 2022 年起從國立台灣大學、國立清華大學、國立陽明交通大學、國立成功大學、國立中央大學、國立中正大學、國立中興大學、國立中山大學，北科大、台科大與高科大共十一所大學之博士研究生中進行推薦，未來將陸續推廣至其它公私立大學。

3-2 已通過博士資格考之博士班研究生。

3-3 經指導教授推薦者。

四、申請時間：

本會於每年 10 月上旬函告各校並開放受理申請。受理申請時間為每年 10 月 15 日至 12 月 15 日止。

五、遴選委員會

由台灣半導體產業協會理事長為遴選委員會主委或委任，並邀請在半導體領域已有卓越成就之學者、專家及產業領導者為委員。

六、頒獎日期：

於次年之本會會員大會或年會中頒獎，獲獎者須親自出席受獎。因故經 TSIA 遴選委員會同意，理監事會核備，同意由其指導教授或該單位最高研發主管出席，受獎得改由他人代之。

七、申請方式：

7-1 申請者備妥申請文件，向各校校方提出申請；本會不直接受理申請。

7-2 請各校於申請截止日期前，向本會推薦。

八、推薦方式：

8-1 各校依第三項規定向本會推薦最多 6 名博士研究生為原則。TSIA 遴選委員會針對各校推薦名單進行初選及複選兩次評選；每校得獎人最多 3 名，共計 10 名，即為得獎人。若複選仍無法選出得獎人，則增口試會議定之。

8-2 若上述申請推薦內容或過程中，有違反事實之情事發生並經查明屬實，本會得撤銷其獲獎資格及獎項。

九、申請文件：

9-1 申請表正本(有制式表格，請向各校索取-附件一) (此為最重要文件，請務必簡潔明確)。

9-2 推薦函正本(有制式表格，請向各校索取-附件二)。

9-3 學生證及身份證正反面影本各乙份(請黏貼於申請表內)。(為保護個資，請自行加註”影本僅限 TSIA 辦理半導體獎申請使用，禁止其他用途“。)

9-4 博士班修習期間成績單正本。

9-5 參與半導體學術研究、著作論文、發明成果、獲獎紀錄、專利榮譽、特殊貢獻、產學合作等傑出事蹟之相關佐證資料。

9-6 申請文件請掃描為單一 PDF 檔案後，上傳至申請表內之申請資料連結網址，以利建檔。

十、遴選方式：

由 TSIA 遴選委員會執行。

十一、其它：

本申請辦法由遴選委員會訂定，經 TSIA 理監事會核備後實施，日後若有修訂，亦同。

十二、若有未盡事宜，本會保留本辦法之變更、解釋及修訂之權利。

十三、聯絡資訊：

張世杰 TSIA 遴選委員會總幹事/國立清華大學教授

電話：(O) 03-574-2964

地址：新竹市 30013 光復路二段 101 號

國立清華大學 資訊工程學系

Email Address: scchang@cs.nthu.edu.tw

附件一、「TSIA 半導體獎：博士研究生」申請表

申請編號 (由本會填寫)		申請日期 (西元年/月/日)	
-----------------	--	-------------------	--

一、個人基本資料：

學校名稱(全稱)	(中文)		
	(英文)		
系所名稱(全稱)	(中文)		
	(英文)		
申請人	(中文姓名)		(英文姓名)
身份證字號		生日	西元 年 月 日
戶籍地址			
通訊地址	(含 6 碼郵遞區號)		
電話	(市話) (手機)	Email	

二、學歷狀況：(請依最高學歷往下填寫)

學位	學校	科系	修習期間 (西元年/月~西元年/月)

三、工作經歷：(若有請填寫，並依最近工作經歷往下填寫)

任職公司	部門/職位	工作內容	任職期間 (西元年/月~西元年/月)

四、研究績效(含論文著作、專利發明、軟體、產品、產學合作、獲獎紀錄等)依重要性排序，最多 8 項，每項扼要敘述最多 5 行。論文著作之說明以第一作者(含共同第一作者)於國際頂尖期刊與會議發表之論文為優先；非第一作者者，請註明本人於該研究中具體貢獻。

請 (A) 提供統計成果；(B) 依重要性排序。

範例如下：

(A) 以第一作者發表 3 篇 IEDM，2 篇 Symp. VLSI，3 篇 IEEE EDL 期刊等

(B) 論文著作：

1. 作者-1、作者-2 等「論文標題」，IEDM，第 1-4 頁，2025 年 12 月

+重點條列方式撰寫，至多 5 行

2. XXX

五、可供徵詢之專家資料

姓名	服務單位/職稱	電話(公司/手機)	Email	與申請人之關係

六、自傳(500 字內)

2

七、自述研究成果或貢獻及其重要性(500 字內，請與“四、研究績效”之項目順序相符，並可將相關項目合併陳述其整體之貢獻與重要性)

八、學生證正反面影本

	
---	---

3

身分證正反面影本

	
---	---

九、應備文件點檢表：

項目	請打 "v"	文件名稱
9-1		申請表正本(有制式表格，請向各校索取-附件一)。
9-2		推薦函正本(有制式表格，請向各校索取-附件二)。
9-3		學生證及身分證正反面影本各乙份(請貼於本申請表)。
9-4		博士班修習期間成績單正本。
9-5		參與半導體學術研究、著作論文、發明成果、獲獎紀錄、專利榮譽、特殊貢獻、產學合作等傑出事蹟之相關佐證資料。
9-6		請連結網址 https://forms.gle/otyX8p5MAQKTMYYE7 ，填寫基本資料，並將 9-1~9-5 文件掃描為單一 PDF 檔案後上傳，以利建檔。



附件二、「TSIA 半導體獎：博士研究生」推薦函

一、被推薦人資料

學校		系所	
姓名		生日	西元 年 月 日
電話	(市話) (手機)	Email	
通訊地址	(含 6 碼郵遞區號)		

二、推薦人資料

任職機構		任職部門	
姓名		職稱	
電話	(市話) (手機)	Email	
通訊地址	(含 6 碼郵遞區號)		
與被推薦人的關係			

三、推薦理由

--

推薦人簽名：

日期： 年 月 日